

## Kurzbeschreibung

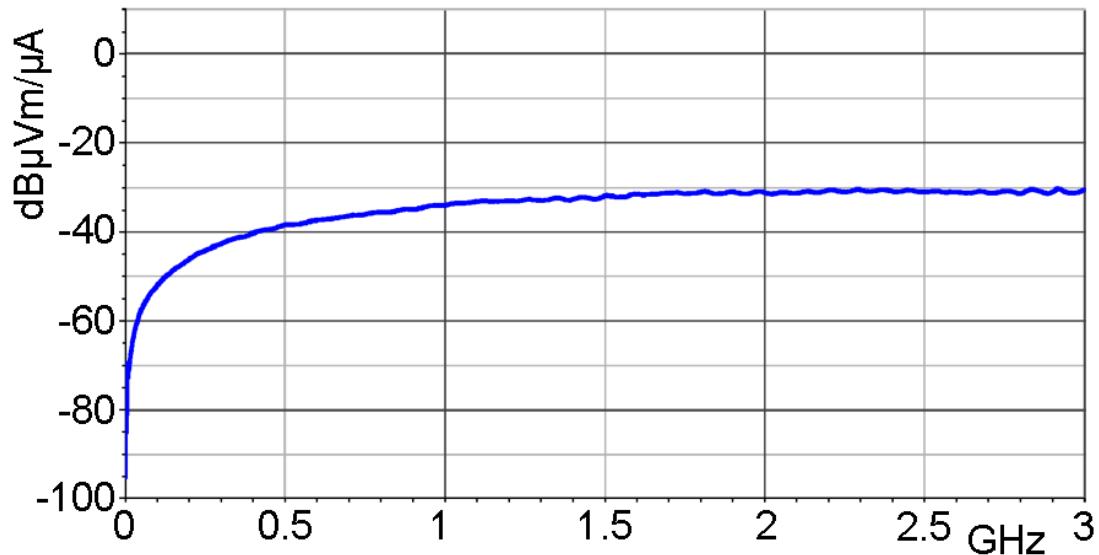
Die Nahfeldsonde RF-R 3-2 dient der Messung von HF-Magnetfeldern mit hoher Auflösung, die unmittelbar auf der Baugruppe, z.B. im Bereich um Pins und Gehäuse von ICs, Leiterzügen, Stützkondensatoren und EMV-Bauelementen.

Die RF-R 3-2 ist eine passive Nahfeldsonde. Sie besitzt den gleichen prinzipiellen Aufbau wie die Sonden RF-R 50-1 und RF-R 400-1. Die Auflösung der RF-R 3-2 ist jedoch wesentlich höher. Die H-Feldsonde ist für Messungen dicht an Bauelementen im Bereich hoher magnetischer Feldstärken geeignet. Für Messungen in größeren Abständen, wie sie mit der RF-R 400-1 und der RF-R 50-1 ausgeführt werden, ist sie nicht geeignet. Die Nahfeldsonde ist klein und handlich. Sie hat eine Mantelstromdämpfung und ist elektrisch geschirmt. Die Nahfeldsonde wird an einen Spektrumanalysator oder ein Oszilloskop mit  $50 \Omega$  Eingang angeschlossen. Die H-Feldsonde besitzt intern keinen  $50 \Omega$  Abschlusswiderstand.

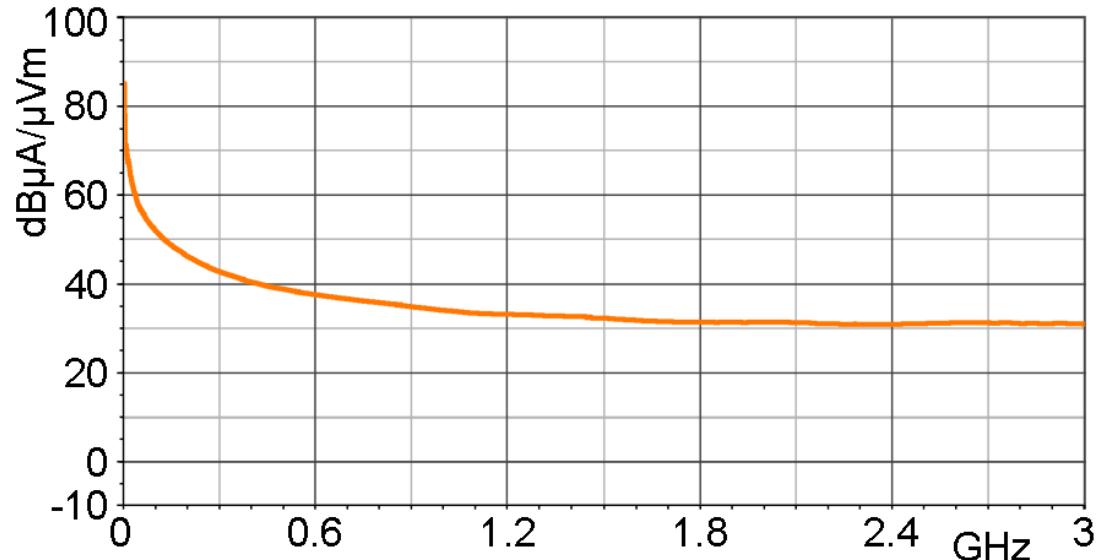
## Technische Parameter

Frequenzbereich	30 MHz ... 3 GHz
Auflösung	$\approx 1 \text{ mm}$
Maße Sondenkopf:	$\varnothing \approx 3 \text{ mm}$
Anschluss - Ausgang	SMB, male, jack
Gewicht	15 g

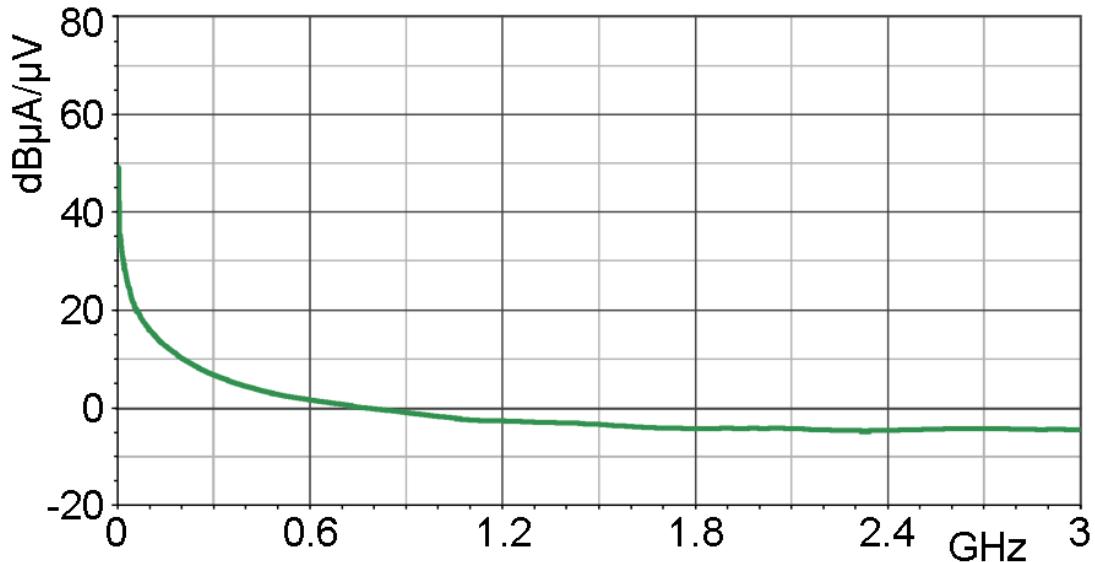
Frequenzgang [ $\text{dB}\mu\text{V}$ ] / [ $\text{dB}\mu\text{A}/\text{m}$ ]



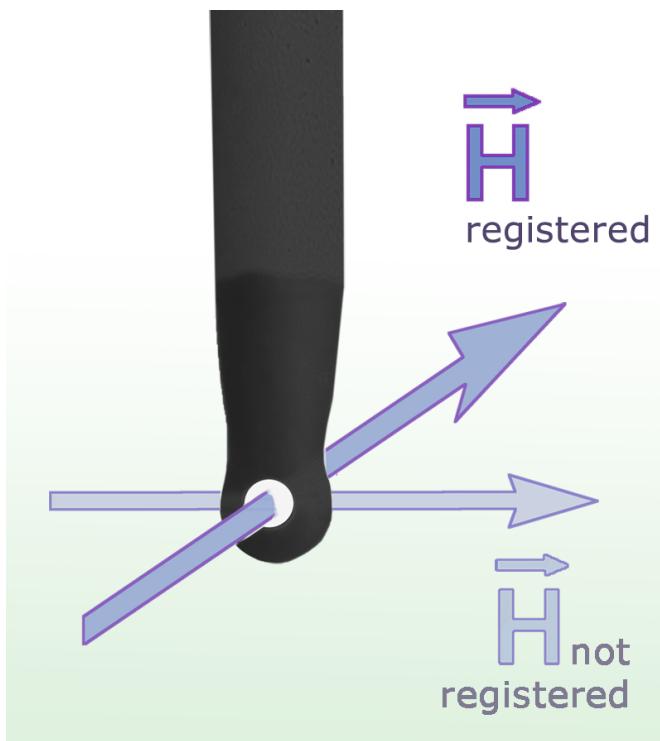
Korrekturkurve H-Feld [ $\text{dB}\mu\text{A}/\text{m}$ ] / [ $\text{dB}\mu\text{V}$ ]



Korrekturkurve Strom [ $\text{dB}\mu\text{A}$ ] / [ $\text{dB}\mu\text{V}$ ]



Messprinzip



# RF-R 3-2

H-Feldsonde 30 MHz bis 3 GHz

**LANGER**  
EMV-Technik

Sondenkopf

